

  Not Actual Photo YIC International Co., Limited. Image may be representation. See specs for product details.	IRLR8729PBF <table><tr><td>Hersteller-Teilenummer:</td><td>IRLR8729PBF</td></tr><tr><td>Hersteller / Marke:</td><td>International Rectifier (Infineon Technologies)</td></tr><tr><td>Teil der Beschreibung:</td><td>MOSFET N-CH 30V 58A D-PAK</td></tr><tr><td>Datenblätter:</td><td> IRLR8729PBF.pdf</td></tr><tr><td>RoHs Status:</td><td>Bleifrei / RoHS-konform</td></tr><tr><td>Lagerzustand:</td><td>New original, 3510 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Liefern von:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Versandweg:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Hersteller-Teilenummer:	IRLR8729PBF	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 58A D-PAK	Datenblätter:	 IRLR8729PBF.pdf	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	Lagerzustand:	New original, 3510 pcs Stock Available.	Liefern von:	Hong Kong	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Hersteller-Teilenummer:	IRLR8729PBF																
Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)																
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 58A D-PAK																
Datenblätter:	 IRLR8729PBF.pdf																
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform																
Lagerzustand:	New original, 3510 pcs Stock Available.																
Liefern von:	Hong Kong																
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS																

Spezifikationen

Teilenummer	IRLR8729PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 58A D-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3510 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.35V @ 25μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.9 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	55W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	58A (Tc)

Sie können auch interessiert

 IRLR8729TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 58A DPAK	 IRLR8726TRPBF IC IR IR TO252	 IRLR8729 MOS IR IR TO-252	 IRLR8729TRLPBF. IR IR SOT8
 IRLR8726TRPBF. IR IR TO-252	 IRLR8729 IR IRLR8729 IR	 IRLR8726TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 86A DPAK	 IRLR8729PBF MOS IR IR TO-252

IRLR8729PBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

International Rectifier (Infineon Technologies)	IRLR8729PBF Datenblatt	IRLR8729PBF-Datenblätter	IRLR8729PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRLR8729PBF
IRLR8729PBF Electronic	IRLR8729PBF-Komponenten	IRLR8729PBF-Verteiler	IRLR8729PBF-Bild	IRLR8729PBF-Teil
IRLR8729PBF Preis	IRLR8729PBF Hersteller	IRLR8729PBF Bild	IRLR8729PBF Aktie	IRLR8729PBF Inventar
IRLR8729PBF Neu	IRLR8729PBF Original	IRLR8729PBF garantiert	IRLR8729PBF RFQ	IRLR8729PBF Online bestellen

Contact us:Info@YIC-Electronics.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited